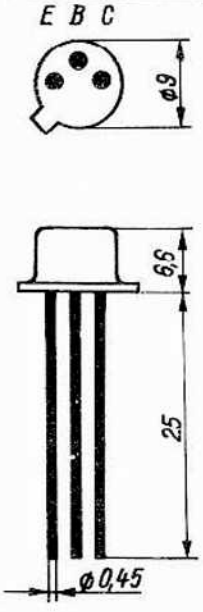
Si-npn-Schalttransistoren
Кремниевые переключающие транзисторы типа n-p-n
n-p-n Si-switching transistors

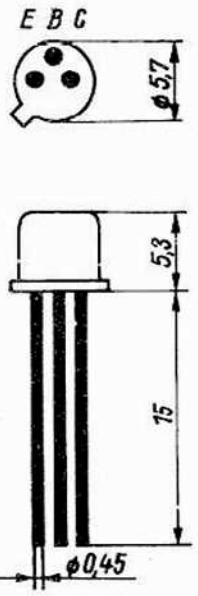
Typ	Grenzdaten bei ϑ_a = 25 °C						Informationsdaten (ϑ_a = 25 °C)									
							bei			bei				bei		bei
	P_{tot} mW	U_{CBO} V	U_{CEO} V	U_{EBO} V	I_C mA	h_{21E}	U_{CE} V	I_C mA	U_{CEsat} V	I_C mA	I_B mA	t_{on} ns	t_{off} ns	I_C mA	I_{CBO} µA	U_{CB} V
SS 106	300	25	15	5	200	18...560	1	10	<0,5	10	1	<40	<75	10	<0,05	15
SS 108	300	40	15	5	200	18...560	1	10	<0,5	10	1	<40	<75	10	<0,05	20
SS 109	300	20	15	5	200	18...280	1	10	<0,5	10	1	<40	<75	10	<0,05	15
SS 216	200	20	15	5	100	18...280	0,5	30	<0,45	30	3	22	280	10	<0,1	20
SS 218	200	20	15	5	100	18...280	0,5	30	<0,45	30	3	<35	<60	10	<0,1	20
SS 219	200	20	15	5	100	18...280	0,5	30	<0,45	30	3	<35	<30	10	<0,1	20
SSY 20	700	60	40	5	600	8...140	1,3	500	<1	500	50	<50	<100	500	<0,2	50

Si-npn-Spezialtransistoren zur Ansteuerung von Ziffernanzeigeröhren
Кремниевые специальные транзисторы типа для наведения ламп цифровой индикации n-p-n
n-p-n Si-special transistors for driving numerical display tubes

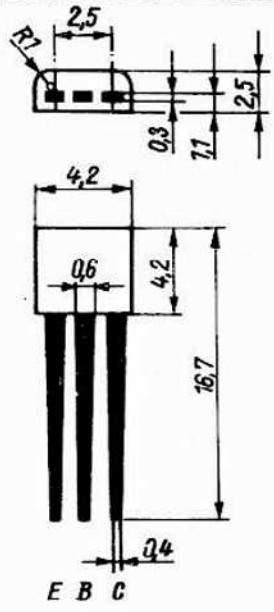
Typ	Grenzdaten bei ϑ_a = 25 °C						Informationsdaten (ϑ_a = 25 °C)								
				bei				bei			bei				bei
	P_{tot} mW	U_{CBO} V	U_{CEV} V	$-U_{BE}$ V	U_{EBO} V	I_C mA	h_{21E}	U_{CE} V	I_C mA	U_{CEsat} V	I_C mA	I_B mA	I_{CEV} µA	U_{CB} V
SS 200	150	70	70	1	5	30	>32	3	10	<3	10	0,31	<1	70
SS 201	150	100	100	1	5	30	>32	3	10	<3	10	0,31	<1	100
SS 202	150	120	120	1	5	30	>32	3	10	<3	10	0,31	<1	120



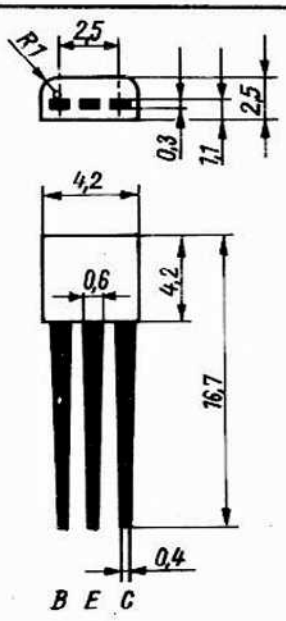
SF 121...SF 123
SF 126...SF 128
SF 150
SSY 20



SF 131, SF 132
SF 136, SF 137
SS 106...SS 109



SC 206, SC 207,
SC 236, SC 237,
SC 238, SC 239,
SF 215, SF 216,
SF 235,
SS 200...SS 202
SS 216...SS 219



SF 225
SF 240, SF 245

Kurzzeichen

A	wirksame Fläche
C_c	Gehäusekapazität
C_{ges}	Eingangskapazität
C_j	Sperrschichtkapazität
C_L	Lastkapazität
C_{tot}	Gesamtkapazität
CMR	Gleichtaktunterdrückung
$d_ü$	Übertragungsdämpfung
E	Beleuchtungsstärke
F	Rauschfaktor
f	Frequenz
f_{h21b}	Grenzfrequenz in Basisschaltung
f_{h21e}	Grenzfrequenz in Emitterschaltung
f_Q	Gütegrenzfrequenz
f_T	Transitgrenzfrequenz
G_{pb}	HF-Leistungsverstärkung in Basisschaltung
h	Höhe
h_{21E}	Gleichstromverstärkung
h_{21e}	Kurzschlußstromverstärkung in Emitterschaltung
I_B	Basisstrom
I_C	Kollektorstrom
I_{CBO}	Kollektorreststrom bei offenem Emitter
I_{CES}	Kollektor-Emitter-Reststrom
I_{CEV}	Kollektorreststrom bei in Sperrichtung vorgespannter Emitterdiode
I_D	Drainstrom
I_D	Blockierstrom
$\hat{I}_{DR}$	Drainspitzenstrom
I_e	Strahlstärke
I_F	Flußstrom, Durchlaßgleichstrom
$\overline{I}_F$	Dauergrenzstrom
$\tilde{I}_F$	Effektiver Durchlaßstrom
I_{FM}	Scheiteldurchlaßstrom
I_{FN}	Nenndurchlaßstrom, Nenngleichstrom
$\hat{I}_{FR}$	Periodischer Spitzenstrom
$\hat{I}_{FS}$	Nichtperiodischer Spitzenstrom
I_{GT}	Zündstrom
I_H	Haltestrom
I_I	Eingangsbiasstrom
I_{IO}	Eingangsoffsetstrom
I_R	Sperrstrom
I_T	Durchlaßstrom
$\overline{I}_T$	Dauergrezstrom
$\tilde{I}_T$	Effektiver Durchlaßstrom
$\hat{I}_{TR}$	Periodischer Spitzenstrom
I_Z	Z-Strom
ΔI_Z	Stabilität des Z-Stroms
I_O	Ausgangsstrom
I_O	Richtstrom
ΔI_O	Richtstromdifferenz
l	Länge
L	Leuchtdichte
L_S	Serieninduktivität
N_O	Ausgangslastfaktor
P_{in}	HF-Eingangsleistung
$\hat{P}_{RS}$	Nichtperiodische Sperrverlustleistung
P_{tot}	Totale Verlustleistung
$R_{äq}$	Äquivalentwiderstand
R_{BE}	Basis-Emitter-Widerstand
R_{DS}	Drain-Source-Widerstand
R_e	Eingangswiderstand
R_g	Generatorwiderstand
R_L	Lastwiderstand
R_{th}	Gesamtwärmewiderstand
R_{thi}	Innerer Wärmewiderstand
r_F	Durchlaßwiderstand
r_R	Sperrwiderstand
r_Z	Z-Widerstand
S	Empfindlichkeit
t_{DHL}	Einschaltverzögerungszeit
t_{DLH}	Ausschaltverzögerungszeit
t_{gt}	Zündzeit
t_{off}	Ausschaltzeit
t_{on}	Einschaltzeit
t_q	Freiwerdezeit
t_r	Anstiegzeit
t_{rr}	Sperrerholungszeit
t_s	Speicherzeit
TK_{UZ}	Temperaturkoeffizient der Z-Spannung
U_{AN}	Nennanschlußspannung (Effektivwert)
U_{BE}	Basis-Emitter-Spannung
$U_{(BR)}$	Durchbruchspannung
U_{CB}	Kollektor-Basis-Spannung
U_{CBO}	Kollektor-Basis-Sperrspannung
U_{CE}	Kollektor-Emitter-Spannung
U_{CEO}	Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei offener Basis
U_{CER}	Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei endlichem Basis-Emitter-Widerstand
U_{CErest}	Kollektorrestspannung
U_{CES}	Kollektorsperrspannung bei kurzgeschlossener Emitterdiode
U_{CEsat}	Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung
U_{CEV}	Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei in Sperrichtung vorgespannter Emitterdiode
U_D	Blockierspannung
U_{DB}	Drain-Bulk-Spannung
U_{DG}	Drain-Gate-Spannung
U_{DM}	Scheitelblockierspannung
$\hat{U}_{DR}$	Periodische Spitzenblockierspannung
$\hat{U}_{DS}$	Nichtperiodische Spitzenblockierspannung
U_{DS}	Drain-Source-Spannung
U_e	Eingangsspannung
U_{EBO}	Emitter-Basis-Sperrspannung
U_F	Durchlaßgleichspannung
U_{GB}	Gate-Bulk-Spannung
U_{GS}	Gate-Source-Spannung
U_{GT}	Zündspannung
U_{HF}	HF-Spannung
U_I	Gleichtakteingangsspannung
U_{ID}	Differenzeingangsspannung
U_{IO}	Eingangsoffsetspannung
U_R	Sperrspannung, Sperrgleichspannung
U_{RM}	Scheitelsperrspannung
$\hat{U}_{RR}$	Periodische Spitzensperrspannung
$\hat{U}_{RS}$	Nichtperiodische Spitzensperrspannung
U_S	Betriebsspannung
U_{SB}	Source-Bulk-Spannung
U_T	Schwellspannung
U_Z	Z-Spannung
ΔU_Z	Stabilität der Z-Spannung
U_{OH}	High-Ausgangsspannung
U_{OL}	Low-Ausgangsspannung
V_U	Spannungsverstärkung
Y_{21}	Steilheit
ϑ_a	Umgebungstemperatur
ϑ_c	Gehäusetemperatur
ϑ_j	Sperrschichttemperatur
$\Delta\vartheta$	Temperaturdifferenz
λ	Emissionswellenlänge
λ_p	Wellenlänge maximaler Emission
$\Delta\lambda$	Spektrale Halbwertsbreite
τ_i	Einschaltzeitkonstante